

JP Kokai Publication Sho-49-102726

1. A method of adhesion treatment comprising steps of attaching an adhesive bonding layer or a bonding layer to an object and pressure-solidifying the layer,

wherein said adhesive bonding layer is formed by applying polymer or material mixing polymer and flattened-particle pigments by electrodeposition on the electroconductive surface, and insufficient state, and

said bonding layer is formed by applying a usual adhesive agent on the adhesive bonding layer.

2. A method of adhesion treatment comprising steps of attaching an adhesive bonding layer or a bonding layer to an object and pressure-solidifying the layer,

wherein said adhesive bonding layer is formed by applying polymer or material mixing polymer and electronic material particles by electrodeposition on the electroconductive surface, and insufficient state; said electronic material particles being conductor, semiconductor, magnetic substance, or ferroelectrics,

said bonding layer is formed by applying a usual adhesive agent on the adhesive bonding layer, and

said object is piezoelectric element, semiconductor element or magnetic element.



(2000円)

特許庁長官 殿

特許法第8条ただし書
の規定による特許出願

昭和48年11月27日



① 日本国特許庁

公開特許公報

① 特開昭 49-102726

④ 公開日 昭49.(1974) 9 27

② 特願昭 48-11724

② 出願日 昭48.(1973) / .29

審査請求 有 (全3頁)

庁内整理番号

⑤ 日本分類

6660 48

24(b)A03

6683.37

24(b)D01

- 1 発明の名称 電圧による炭素層の形成方法
- 2 特許請求の範囲に記載された発明 1
- 3 発明者 出願人と同じ
- 4 特許出願人

住所 2777-2222 東京都中央区新富1丁目1番地5

氏名 田中 孝 田中 孝

5 特許書類の目録

(1) 願書原本

(2) 明細書

(3) 出願書並請求書

(4) 図面

1 通

1 通

1 通

1 通



明 細 書

方法。

1 発明の名称

電圧による炭素層の形成方法

2 特許請求の範囲

1. 導電性炭面に高分子またはそれに類する粒子状の原料を塗布した材料を電圧作用によって炭化させた炭素成状態の材料層に、あるいはさらにその上に通常の炭素層を塗布してなる複合層に、所定の炭素層を密着させたのち炭素成層を圧着固化させる炭素処理の方法。
2. 導電性炭面に高分子またはそれに類する液体、半導体、有機体あるいは無機体のとき電子材料、炭素粒子を形成した材料を電圧作用によって炭化させた炭素成状態の材料層に、あるいはさらに通常の炭素層を塗布してなる複合層に、圧電素子、半導体素子および炭素素子のとき所定の炭素層を密着させ、しかもその炭素成層を圧着固化させる炭素処理の方法。

3 発明の要旨を説明

一般に金属材料あるいは極めて小さな微細部の金属材料を他の被接合物質の表面に接合するには、真空炉内等で作られた通常の炭素層を被接合物質に何らかの方法にて直接塗布し乾燥させて両者の接合をなすしめる。しかし炭素層そのもの重量割合は良くとも金属材料に対する接合効果は通常をわけて早く、また安定性に劣る。殊に少量の炭素層しか使えないような場合には強固な接合性を得ることが困難である。本発明の方法は金属材料の他の導電性炭面において電圧作用をともなう高分子等を炭化させる炭素成状態によって、塗布した炭素層あるいはこれに原料を配合したものが極めて緻密かつ強固に金属材料に対して被着させることができるので、これを接合界面層（または中間層）として利用したものである。

すなわち炭素層を界面とし、他の被接合物質

るとともに、エポキシ樹脂とその他の樹脂とを混合し、同時に硬化を促進することによって、硬化面上に高分子膜を形成させることができる。この方法によれば、極めて複雑な形状の面あるいは極めて小さな部分に対して、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。この場合、硬化促進剤の添加量を適切に調整することにより、被覆膜の厚みを制御することができる。そして、この被覆膜が完成した後は、硬化剤の添加量について調整を行うことができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。また、このようにして作られた被覆膜からは、硬化剤と水分の揮発が抑えられるので、極めて安定した強度な被覆膜を形成することができる。

次に、被覆膜について述べる。

被覆膜の厚みを調整する場合は、硬化剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。

等しいものを用いて、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。

次に、被覆膜の厚みを調整する方法について述べる。図面に示すように、半導体素子上に被覆膜が形成されたとき、その厚さを調整するために、被覆膜の厚さを調整する方法として、硬化促進剤の添加量を調整する方法がある。この場合、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。また、このようにして作られた被覆膜からは、硬化剤と水分の揮発が抑えられるので、極めて安定した強度な被覆膜を形成することができる。

本発明の方法によれば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。

さらに、被覆膜の厚みを調整する方法について述べる。図面に示すように、半導体素子上に被覆膜が形成されたとき、その厚さを調整するために、被覆膜の厚さを調整する方法として、硬化促進剤の添加量を調整する方法がある。

特開 昭49-102726 (2)

れまたはその一方の全面に被覆膜の厚さを均一に形成させることができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。

このような本発明の方法によれば、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。この場合、例えば、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。また、このようにして作られた被覆膜からは、硬化剤と水分の揮発が抑えられるので、極めて安定した強度な被覆膜を形成することができる。

は、被覆膜の厚みを調整する方法について述べる。図面に示すように、半導体素子上に被覆膜が形成されたとき、その厚さを調整するために、被覆膜の厚さを調整する方法として、硬化促進剤の添加量を調整する方法がある。この場合、硬化促進剤の添加量を調整することによって、被覆膜の厚みを均一に形成させることができる。また、このようにして作られた被覆膜からは、硬化剤と水分の揮発が抑えられるので、極めて安定した強度な被覆膜を形成することができる。

以上に示した実験例からもわかるように、本発明の方法は、僅めて広い適用面がある。そして、組合材料の中心因性体、即ち、半導体あるいは超導体のごとき電子材料としての用途をもつ材料の陰極子を、電場誘導媒質中に僅改して電結することにより、その電気的特徴を付与した組合膜を形成することが出来る。

例へば上に述べた美地例のほかに、
知床子の電気的加熱と全身の循環的運動とを
促進よく完成するのためのトランスジェーサー
を用いた、
いほ運動かつ全身の電気的運動の調整などには
極めて効果的な手段となり、
生産性にも富む方法
である。

4 站 西 中 國 年 在 經 濟

第1回人は金貨検査局に申請検査を怠りし
た上開國であり、第1回日はその開國日を例示
したものである。

そして第 2 図は同値の γ の相違を示す原理
図である。

人 類 學 下 冊

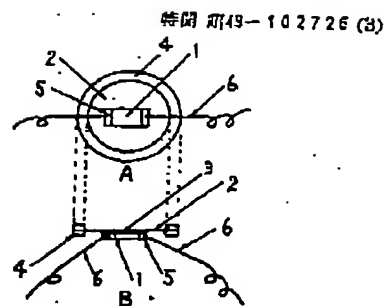


圖 1

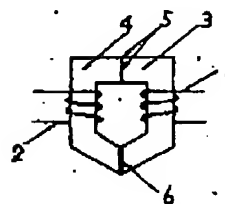


图 2.4